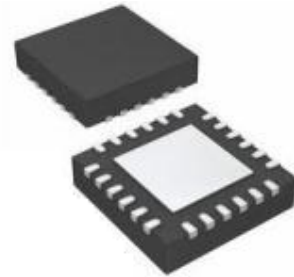


三相无刷电机驱动

产品简述

MS39361N 为一款三相无刷电机的驱动芯片，工作电压范围 3V~10V，适合一节或者两节锂电池应用，最大持续输出驱动电流 2A。

芯片采用 PWM 脉冲驱动的方式来减少输出功耗，通过调节外部信号的占空比来调节电机的转速；芯片内置堵转保护电路，可以在电机正常运转但 Hall 信号输入异常时，起到保护芯片的作用。



QFN24

主要特点

- 持续输出电流 2A
- 工作电压 3V~10V
- 低输出阻抗上臂桥 0.16Ω，下臂桥 0.16Ω
- 使用直接 PWM 输入进行速度控制和同步整流
- 1-Hall 和 3-Hall FG 输出
- CSD 堵转保护电路
- 可切换正、反转工作模式
- Stop 模式下的节电功能
- 过温保护、过流限流保护
- 低电压欠压保护，3V 或 5V 可选
- 3.4V LDO 稳压输出给 Hall 供电

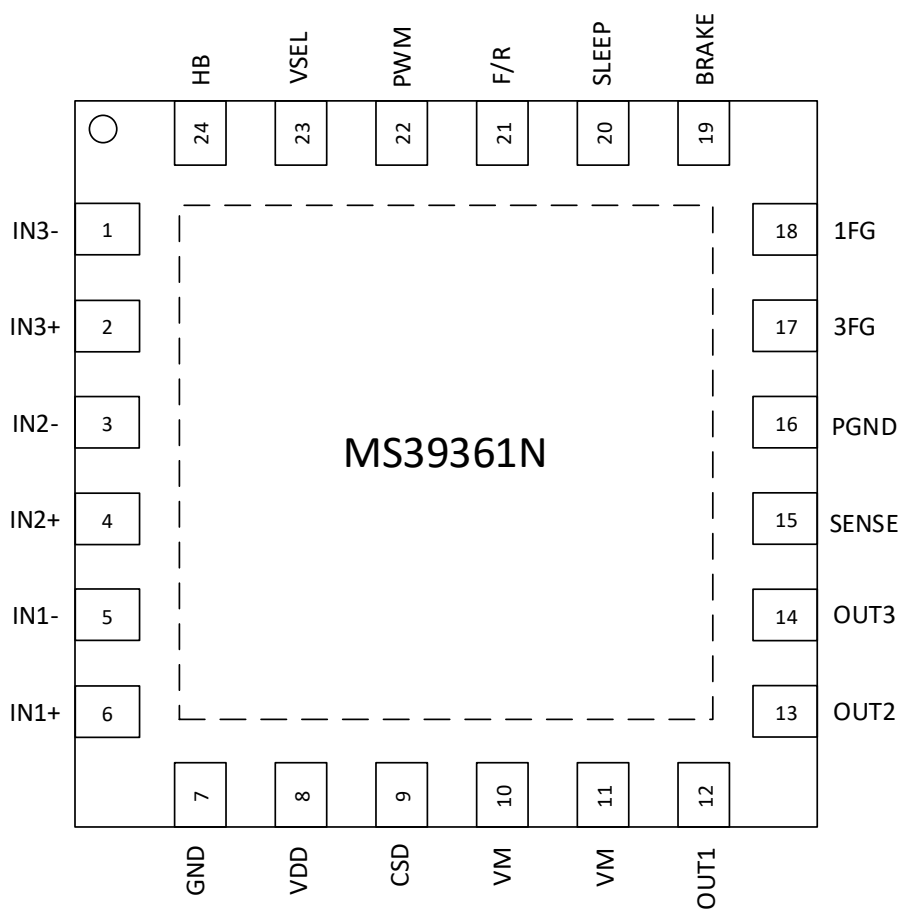
应用

- 小家电
- 卷发器
- 剃须刀
- 风扇

产品规格分类

产品	封装形式	丝印名称
MS39361N	QFN24	MS39361N

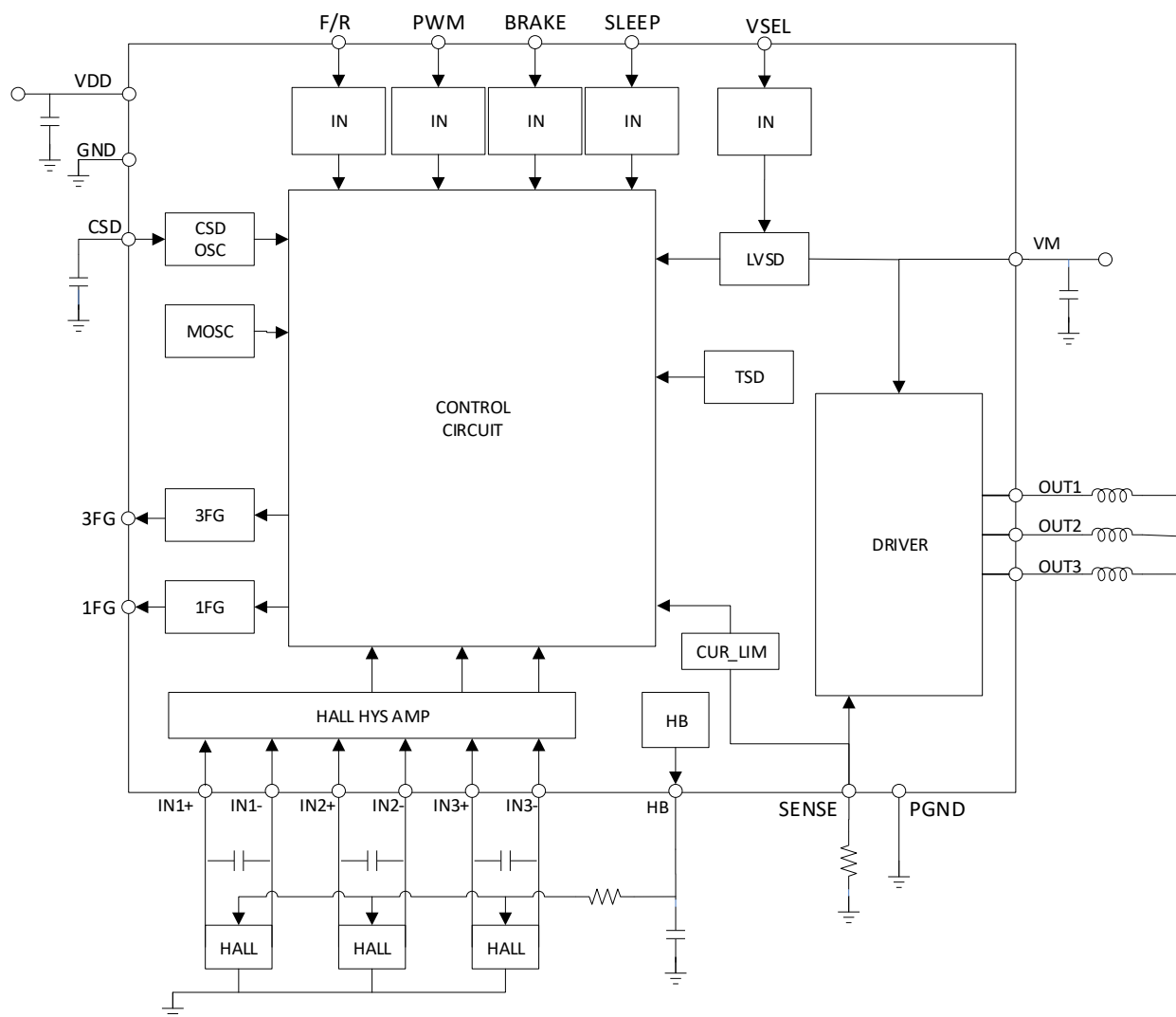
管脚图



管脚说明

管脚编号	管脚名称	管脚属性	管脚描述
1	IN3-	I	Hall 信号输入 H: IN+>IN-; L: IN->IN+
2	IN3+		
3	IN2-		
4	IN2+		
5	IN1-		
6	IN1+		
7	GND	-	逻辑地
8	VDD	-	逻辑电源输入
9	CSD	I	CSD 堵转保护电容
10, 11	VM	-	功率电源，内部短接
12	OUT1	O	输出 1
13	OUT2	O	输出 2
14	OUT3	O	输出 3
15	SENSE	-	输出电流检测电阻
16	PGND	-	功率地
17	3FG	O	3-Hall 信号输出
18	1FG	O	1-Hall 信号输出
19	BRAKE	I	刹车输入（高电平刹车）
20	SLEEP	I	休眠输入（低电平休眠）
21	F/R	I	电机方向输入
22	PWM	I	PWM 输入（低电平有效）
23	VSEL	I	低压保护电压设置脚，可设置 3V 或 5V
24	HB	I	3.4V 稳定输出，给 Hall 供电

内部框图



极限参数

芯片使用中，任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏，芯片长时间处于极限工作状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出，并不代表芯片可以正常工作在此极限条件下。

参数	符号	测试条件	额定值	单位
最大工作电压	VDD _{Max}		6	V
	VM _{Max}		12	V
输出电流	I _{Max}	长时间工作	2	A
最大功耗	Pd _{Max}	接上电路板	1.35	W
结温	T _J		150	°C
工作温度	T _A		-40 ~ 125	°C
存储温度	T _{STG}		-65 ~ 150	°C
ESD (HBM)	V _{ESD}		>4	kV

电气参数

管脚参数

无其他说明, $T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压	V_M		3.0		10	V
VDD 管脚电压	V_{VDD}		2.9		6	V
HB 管脚电流	I_{HB}				10	mA
FG 应用电压	V_{FG}		0		6	V
FG 管脚电流	I_{FG}				10	mA

电气特性

无其他说明, $T_A=25^{\circ}\text{C}$, $V_M=9\text{V}$, $V_{DD}=3.3\text{V}$

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电流 1	$ICC1_{VM}$	占空比 50%, 无负载, HB 无负载		1.1		mA
	$ICC1_{VDD}$			2.5		mA
省电电流 2	$ICC2_{VM}$	PWM 长期为高		0.44		mA
	$ICC2_{VDD}$			2.4		mA
休眠电流 3	$ICC3_{VM}$	SLEEP=0 或 悬空			1	μA
	$ICC3_{VDD}$	SLEEP=0 或 悬空			1	μA
输出模块						
下臂管导通电阻	$R_{ON(L1)}$	$I_O=1\text{A}$		0.16		Ω
上臂管导通电阻	$R_{ON(H1)}$	$I_O=-1\text{A}$		0.16		Ω
下臂漏电	$I_{L(L)}$				50	μA
上臂漏电	$I_{L(H)}$		-50			μA
下臂桥二极管正偏电压	$V_{D(L1)}$	$I_D=-2\text{A}$		1		V
上臂桥二极管正偏电压	$V_{D(H1)}$	$I_D=2\text{A}$		1		V
Hall 放大器						
输入电流	$I_{B(HA)}$		-130			nA
共模电压 1	V_{ICM1}	使用元件	0.3		$V_{DD}-1.3$	V
共模电压 2	V_{ICM2}	在一边的输入偏置 (Hall IC 应用)	0		V_{DD}	V
Hall 输入灵敏度	V_{HIN}	正弦波	50			mV _{p-p}

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
迟滞宽度	$\Delta V_{IN(HA)}$			15		mV
CSD 振荡器						
CSD 脚高电压	$V_{OH(CSD)}$			$V_{DD} \times 2/3$		V
CSD 脚低电压	$V_{OL(CSD)}$			$V_{DD} \times 1/3$		V
幅度	$V_{(CSD)}$			$V_{DD} \times 1/3$		V _{p-p}
外部电容的充电电流	I_{CHG1}	$V_{CHG1}=2V$		-5.7		μA
外部电容的放电电流	I_{CHG2}	$V_{CHG2}=2V$		7		μA
内部振荡器频率	$f_{(CSD)}$	$C=0.022\mu F$		123		Hz
内部 PWM 频率						
振荡频率	$f_{(PWM)}$			43		kHz
限流保护						
限制电压	V_{SENSE}			0.2		V
过流保护						
输出管过流保护	I_{OCPUP}	OUT 对 GND 短路	3			A
	I_{OCPDW}	VM 对 OUT 短路	3.2			A
过流保护触发时间	t_{LITCH}	过流保护触发持续的时间		3		μs
过流保护重启时间	t_{RETRY}	过流关断后自重启时间		11.5		ms
过温保护						
关断温度	T_{SD}	结温	140	147	160	°C
迟滞	ΔT_{SD}	结温		40		°C
HB 脚						
电压	V_{HB}	$I_{HB}=100\mu A, V_M=9V$		3.4		V
低压检测(VDD)						
激活电压	V_{SD0}	V_{DD} 上升		2.5		V
迟滞宽度	ΔV_{SD}			100		mV
低压检测(VM)						
激活电压	V_{SD1}	V_M 上升, $V_{SEL}=0$		2.7		V
	V_{SD2}	V_M 上升, $V_{SEL}=1$		5.5		V

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
迟滞宽度	ΔV_{SD1}	上升减去下降		150		mV
	ΔV_{SD2}	上升减去下降		700		mV
3FG, 1FG 脚						
导通电阻	$R_{ON(FG)}$	$I_{FG}=5mA$		7		Ω
漏电流	$I_{L(FG)}$	$V_O=5V$			1	μA
SLEEP, PWM, BRAKE, VSEL, F/R 逻辑输入脚						
高电平输入电压	V_{IH}		1.8		V_{DD}	V
低电平输入电压	V_{IL}		0		1.1	V
下拉电阻值	R_{IN}			268		k Ω
迟滞宽度	V_{IS}			400		mV

三相电机逻辑真值表

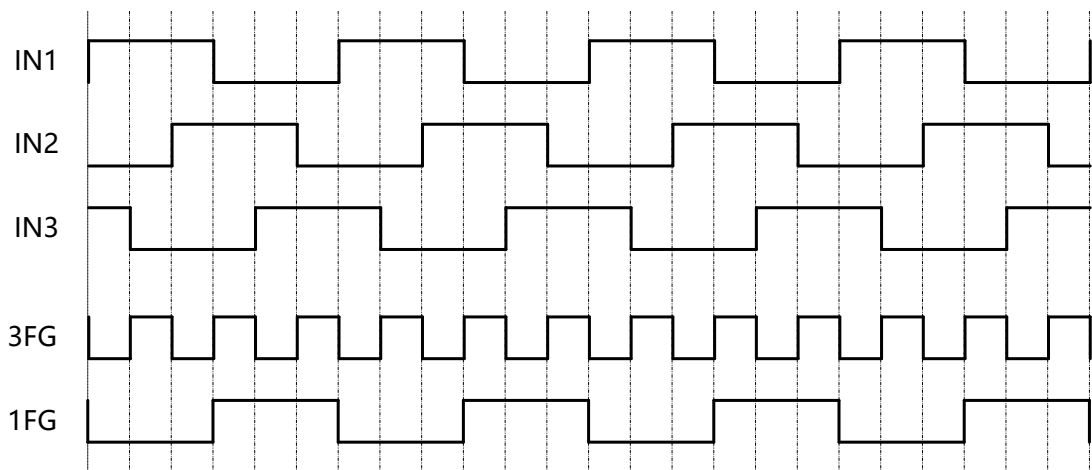
(IN="High"表示 $IN^+ > IN^-$)，（输出 1~3 中"H"=SOURCE,"L"=SINK,M=OFF）

F/R=H			F/R=L			OUTPUT		
IN1	IN2	IN3	IN1	IN2	IN3	OUT1	OUT2	OUT3
H	L	H	L	H	L	L	H	M
H	L	L	L	H	H	L	M	H
H	H	L	L	L	H	M	L	H
L	H	L	H	L	H	H	L	M
L	H	H	H	L	L	H	M	L
L	L	H	H	H	L	M	H	L

3FG, 1FG 输出逻辑

芯片内部没有对输入的霍尔信号做处理，根据逻辑直接输出，如果 3FG 出现波形宽窄不一致的时候请检测霍尔位置以及充磁的均匀性。3FG 和 1FG 的输出逻辑表和时序图如下所示。

IN1	IN2	IN3	3FG	1FG
H	L	H	L	L
H	L	L	H	L
H	H	L	L	L
L	H	L	H	H
L	H	H	L	H
L	L	H	H	H



SLEEP, BRAKE, PWM, F/R 逻辑表

逻辑 控制管脚 输入状态	BRAKE	PWM	F/R	SLEEP
高	刹车	关断	反转	正常工作
低（默认态）	开启	开启	正转	休眠模式

功能描述

驱动模块

芯片采用 PWM 的驱动方式减小功耗，通过调整输出模块上臂管的打开与关断来实现调节功能，电机的驱动强度由其占空比决定。

当正常的 PWM 关断时，同步整流开始发挥作用，相比 LDMOS 寄生的二极管续流，下臂管导通续流大大减小了热量的产生。

限流保护

限流保护电路用于限制输出电流的最大峰值，由 V_{RF}/R_f 决定（ $V_{RF}=0.21$ （典型）， R_f 为电流检测电阻）。电路通过减小输出导通占空比，来限制输出电流。

过流保护电路在检测 PWM 工作时，在二极管中流过的反向电流会有一个 700ns 左右的工作延时，从而防止限流电路工作异常。如果电机绕组的内阻或电感太小，在启动时（电机中没有反向电动势的产生），电流将会快速变化。这个工作延时可能会导致在大于设定值时才限流。因此在设定限流值时，有必要考虑延时引起的增加。

注意，在限流电路中，PWM 频率是由内置的振荡器决定的，大概 43kHz。

过流保护

过流保护电路监测流经驱动管的电流，当遇到输出与电源短接，输出与 GND 短接，输出之间短接等异常情况时，那么当芯片监测到驱动管电流超过过流保护阈值，且时间超过 3μs 时，控制器关断输出管；关断持续时间 11ms，11ms 后重新打开驱动管。

速度控制方法

脉冲从 PWM 管脚输入，可以通过调节 PWM 的占空比来调节电机速度。

当 PWM 为 0 时，为 ON 态；当 PWM 为 1 时，为 OFF 态。

如果有必要使用反向逻辑，可以额外加入一个 NPN 管。当 PWM 持续高电平，芯片会判定占空比为 0，从而导致 CSD 电路计数重置并且 HB 脚的输出为 0。

CSD 保护电路

MS39361N 包含一个堵转保护电路，当电机正常运转但 Hall 信号长时间不变化时，电路开始工作。当 CSD 电路工作时，所有输出上臂管全部关断。

时间由连接 CSD 脚的电容决定。设置时间=90×C(μF)。

当一个 0.022μF 的电容接入时，保护时间约 2s。设置时间必须足够大以满足电机的启动时间。计数被重置的条件：

SLEEP 为低	——>	保护释放并重新计数（重置初始态）
BRAKE 端为高	——>	保护释放并重新计数（重置初始态）
F/R 正反转调节	——>	保护释放并重新计数
在 PWM 管脚上检测到 0% 占空比	——>	保护释放并重新计数
检测 到低压条件	——>	保护释放并重新计数（重置初始态）
检测 到 TSD 条件	——>	停止计数

当 CSD 脚接地，逻辑电路将进入初始态，防止发生速度控制。当不需要使用 CSD 保护功能时，将大小近 220kΩ 的电阻和 4700pF 的电容器并联对地。

低压保护

MS39361N 通过结合比较器，使用带隙电压作基准进行比较，电路检测 VM 电压，当 SLEEP 为高且 VDD 电压低于 VSD 时，所有输出晶体管将被关断。

芯片提供选择管脚 VSEL，当 VSEL=0 时，低压保护 VSD 在 2.7V 左右；当 VSEL=1 时，VSD 在 4.8V 左右，分别针对一节与两节的锂电池应用。

过温保护

当芯片结温超过 147°C 时，过温保护电路被激活，关断所有输出管。当温度恢复到 107°C 时（147°C - 迟滞温度 40°C），所有输出管恢复工作。

但是，由于过温保护仅仅在芯片结温超过设定值才会被激活，它并不能保证产品就能免受破坏。

Hall 输入信号

幅度超过迟滞（最大 35mV）的 Hall 信号可以被识别，但考虑到噪声效应以及相位偏移，至少大于 100mV 的幅度为最佳。为了减少输出噪声的干扰，可以在 Hall 输入端接对地电容。在 CSD 保护电路中，Hall 输入作为一个判断信号。虽然电路能无视大量的噪声，但关注是有必要的。Hall 信号同时为 HHH 或者 LLL 时被认为是错误态，将关闭所有输出管。

如果使用到 Hall 芯片，在一端固定（无论正负）一个共模电平范围(0.3V ~ V_{DD}-1.3V)，允许另一端的电压范围可以为 0V ~ V_{DD}。

连接 Hall 元件的方法：

(1) 串联

优点：

- 电流被串联的 Hall 元件所共享，所以电流消耗相比并联更小
- 限流电阻可以省去
- 幅度随温度变化小

缺点:

- 每个 Hall 元件只能被分到 1V，也就存在幅度不满足的可能
- 流过 Hall 元件的电流随温度变化
- Hall 元件的不对称（输入电阻的不同）很容易影响幅度

(2) 并联

优点:

- 流过 Hall 元件的电流由限流电阻决定
- Hall 元件的电压可以是多样化的，并且可以满足足够的幅度

缺点:

- 由于需要为每个 Hall 元件单独提供电流，功耗较大
- 需要一个限流电阻
- 幅度随温度变化

HB 脚

HB 脚可用于在省电模式下关断 Hall 元件电流。在以下情况，HB 脚将会被关闭。

- 当 SLEEP 变低，进入省电态
- PWM 输入检测到 0% 占空比

省电模式

MS39361N 提供两级省电模式，第一级省电模式的触发方式，是输入 PWM 为高电平超过一定时间，芯片会关断 HB、驱动与部分电路的供电；第二级深度省电模式，是使 SLEEP 输入置低，所有电路都被关断，此时电流小于 1 μ A。

功率电源 VM 稳定性

芯片产生大的输出电流，并且采用一种开关驱动的方式，电源线势必会被轻易地干扰。为此，为保证电压稳定，需要在 VM 和地之间接入一个足够大的电容。电容地端接到 PGND（功率地）上，尽可能得靠近管脚。如果不可能在 VM 脚上接入大电容，可在管脚附近接入 0.1 μ F 的陶瓷电容。

如果在电源线上嵌入一个二极管以防止电源线反接，那么电源线更容易被干扰，这就需要更大的电容。

VDD 电源

VDD 电源给芯片的输入接口、逻辑控制、模拟部分供电，需要在 VDD 与 GND 端接一个稳定电容。VDD 的工作范围在 2.9V ~ 6V，当一节锂电池给功率电源 VM 供电时，也可以直接给 VDD 供电。当使用两节锂电池时，VDD 必须通过外部 MCU 或 LDO 供电。

电荷泵

芯片内置电荷泵，不需要额外的管脚与电容。

使用须知

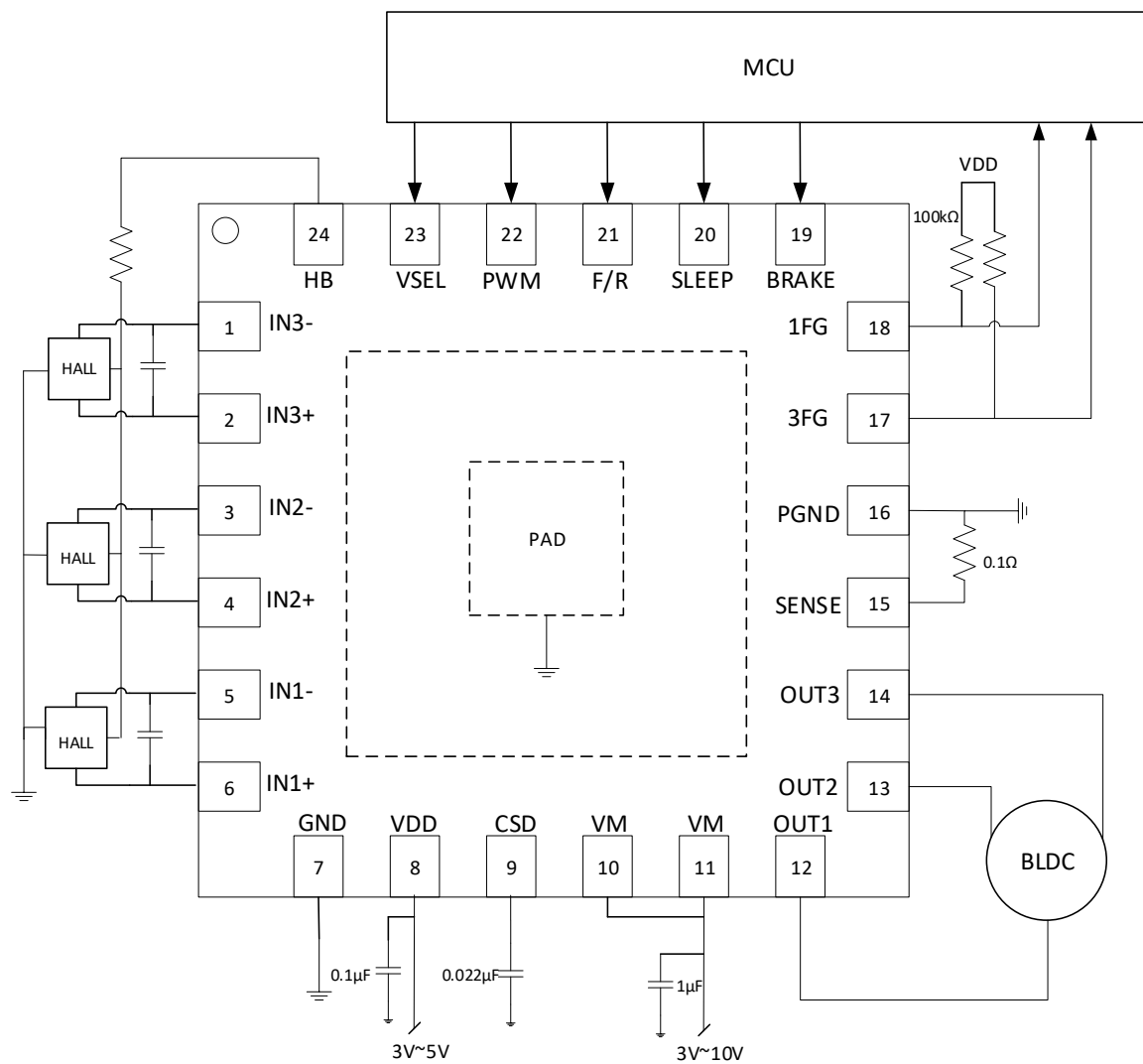
芯片具有同步整流功能，可以提高驱动效率。同步整流开始发挥作用，相比 LDMOS 寄生的二极管续流，下臂管导通续流大大减小了热量的产生。可是，同步整流可能引发电源电压的上升，比如以下情况：

- 输出占空比突然减少
- PWM 输入频率突然降低

为了保护芯片即使在电源电压上升时，也不会超过极限参数，必须采取有效措施，包括：

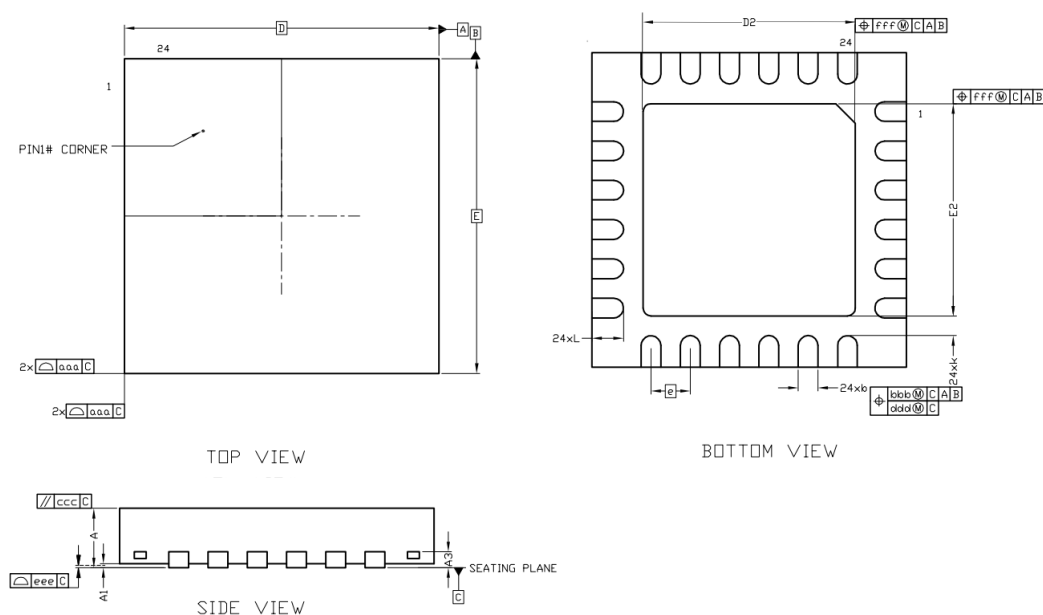
- 电源到地的大电容的选择
- 电源到地的二极管的接入

典型应用图



封装外形图

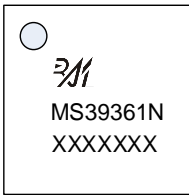
QFN24



符号	尺寸（毫米）		
	最小值	典型值	最大值
A	0.70	0.75	0.80
A1	0	0.02	0.05
A3	-	0.20REF	-
b	0.18	0.25	0.30
D	4.00BSC		
E	4.00BSC		
D2	2.60	2.70	2.80
E2	2.60	2.70	2.80
e	0.50BSC		
L	0.35	0.40	0.45
K	0.20	-	-
aaa	0.10		
bbb	0.10		
ccc	0.10		
ddd	0.05		
eee	0.08		
fff	0.10		

印章与包装规范

1. 印章内容介绍



产品型号：MS39361N

生产批号：XXXXXXX

2. 印章规范要求

采用激光打印，整体居中且采用 Arial 字体。

3. 包装规范说明

型号	封装形式	颗/卷	卷/盒	颗/盒	盒/箱	颗/箱
MS39361N	QFN24	4000	1	4000	8	32000

声明

- 瑞盟保留说明书的更改权，恕不另行通知！客户在下单前应获取最新版本资料，并验证相关信息是否完整。
- 在使用瑞盟产品进行系统设计和整机制造时，买方有责任遵守安全标准并采取相应的安全措施，以避免潜在失败风险可能造成的人身伤害或财产损失！
- 产品提升永无止境，本公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！



MOS电路操作注意事项

静电在很多地方都会产生，采取下面的预防措施，可以有效防止 MOS 电路由于受静电放电的影响而引起的损坏：

- 1、操作人员要通过防静电腕带接地。
- 2、设备外壳必须接地。
- 3、装配过程中使用的工具必须接地。
- 4、必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。



+86-571-89966911



杭州市滨江区伟业路 1 号
高新软件园 9 号楼 701 室



[http:// www.relmon.com](http://www.relmon.com)